

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

1次写真蝕刻工程を用いて、TFT部及びパッド部の基板上に耐火性金属で形成した第1金属膜及びアルミニウム又はアルミニウム合金で形成した第2金属膜が順次に積層されてなるゲート電極及びゲートパッドを各々形成する段階と、

ゲート電極及びゲートパッドが形成された前記基板の全面に絶縁膜を形成する段階と、

2次写真工程を用いてTFT部の前記絶縁膜上に半導体膜パターンを形成する段階と、

3次写真工程を用いてTFT部に第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を形成する段階と、

ソース電極及びドレイン電極が形成された基板の全面に保護膜を形成した後、前記保護膜及び絶縁膜を4次写真蝕刻して前記TFT部のドレイン電極と前記パッド部のゲートパッドの一部を露出させる保護膜パターンを形成する段階と、

前記保護膜パターンをマスクとして前記第2金属膜を蝕刻してパッド部の第1金属膜を露出させる段階と、

5次写真工程を用いて前記TFT部のドレイン電極と接触する第1画素電極パターンと、前記パッド部の第1金属膜と接触する第2画素電極パターンを形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。 10

【請求項 2】

前記第1金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。 20

【請求項 3】

前記第3金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 4】

前記1次写真蝕刻工程で第2金属膜に対してテープ蝕刻を行い、引続き第1金属膜に対して蝕刻を行うことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 5】

前記絶縁膜はSiNx及びSiNxとSiOxとの二重膜よりなるグループから選択された何れか1つで形成することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 6】

基板上に形成された第1金属膜と、前記第1金属膜上に形成された第2金属膜よりなるゲート電極と、

前記基板上に形成された第1金属膜と、前記第1金属膜上的一部分に形成された第2金属膜よりなるゲートパッドと、

前記ゲート電極及びゲートパッドが形成された基板上に、前記ゲートパッドの第1金属膜の一部を露出させるように形成された絶縁膜と、

ゲート電極上の前記絶縁膜上に形成された半導体膜パターンと、

前記半導体膜パターン上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、

前記ドレイン電極を露出させるコンタクトホールと前記ゲートパッドの第1金属膜を露出させるコンタクトホールを持つように形成された保護膜パターンと、

前記保護膜パターン上に形成され、前記ドレイン電極と接触する第1画素電極パターンと、

前記保護膜パターン上に形成され、前記ゲートパッドの第1金属膜と接触する第2画素電極パターンとを具備し、

前記第1金属膜は耐火性金属で形成され、前記第2金属膜はアルミニウム又はアルミニウム合金で形成されることを特徴とするTFT基板。 40

【請求項 7】

前記第1金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つよりなることを特徴とする請求項6に記載のTFT基板。

【請求項 8】

50

前記絶縁膜は窒化膜 SiN_x よりなることを特徴とする請求項 6 に記載の TFT 基板。

【請求項 9】

前記第 1 画素電極パターン及び前記第 2 画素電極パターンは ITO よりなることを特徴とする請求項 6 に記載の TFT 基板。

【請求項 10】

前記保護膜パターンの一部は前記半導体膜パターンと直接接触することを特徴とする請求項 6 に記載の TFT 基板。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は液晶表示装置の製造方法に係り、特に能動素子として薄膜トランジスタを具備して写真工程の数が減らすことのできる液晶表示装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

情報表示装置は電気的な信号を視覚映像に変換させ、人間が直接情報を解読可能にする電子システムの一種であって、電子光学的素子である。このような表示装置としては液晶表示装置 (Liquid Crystal Display: LCD) が最も広く使用されており、その他にもプラズマ放電を用いるプラズマ表示装置 (Plasma Display Panel: PDP) 、エレクトロルミネンス (Electro Luminescence: EL) 、最近多く研究されている電界放出表示装置 (Field Emission Display: FED) 、そして反射形としてミラーの動きを制御する可変ミラー素子 (Deformable Mirror Device: DMD) 等が開発され急速に普及している。

【0003】

その中で、液晶表示装置は電場により分子の配列が変化する液晶の光学的性質を用いる液晶技術と、微細パターンを形成することができる半導体技術とを合わせた表示装置であって平板表示装置の代名詞と言われる。液晶表示装置の中の、薄膜トランジスタを能動素子として使用する薄膜トランジスタ液晶表示装置 (Thin Film Transistor LCD: TFT-LCD) は低消費電力、低電圧駆動力、薄形、軽量等の多様な長所を有している。

【0004】

一方、薄膜トランジスタ (以下 TFT と称する) は一般トランジスタに比べて非常に薄いので、この製造工程は一般トランジスタの製造工程より複雑で生産性が低く、製造コストも高い。特に製造段階毎にマスクが使用され少なくとも 7 枚のマスクが必要である。従って、TFT の生産性を高め、製造コストを低めるための様々な方法が研究されており、特に製造工程に使用されるマスクの数を減らすための方法が広く研究されている。

【0005】

以下、添付した図面に基づき従来の技術による液晶表示装置の製造方法を説明する。

図 1 乃至図 4 は従来の技術による液晶表示装置の製造方法を説明するため示した断面図であって、特許文献 1 を参照したものである。各図で部材符号 A は TFT 部を示し、B はゲート - パッド連結部を示す。

【0006】

図 1 を参照すれば、透明な基板 2 上に純粋アルミニウムを使用して第 1 金属膜を形成した後、前記第 1 金属膜を 1 次写真蝕刻してゲートパターン 4、4 a を形成する。前記ゲートパターンは TFT 部ではゲート電極 4 として、ゲート - パッド連結部ではゲートパッド 4 a として使用される。

図 2 を参照すれば、通常の写真工程を行ってゲート - パッド連結部の一部領域を遮断するフォトレジストパターン (図示せず) を形成した後、前記フォトレジストパターンを酸化防止膜にて使用して前記第 1 金属膜を酸化させ陽極酸化膜 6 を形成する。この際、前記陽極酸化膜 6 は TFT 部に形成されたゲート電極 4 の全面と、ゲート - パッド連結部に位置するゲートパッド 4 a の一部領域上に形成される。

【0007】

図 3 を参照すれば、陽極酸化膜 6 が形成された前記基板 2 の全面に、例えば窒化膜を蒸

10

20

30

40

50

着して絶縁膜 8 を形成する。次いで、絶縁膜 8 が形成された基板 2 の全面に非晶質のシリコン膜 12 を連続的に蒸着して半導体膜を形成した後、前記半導体膜を 3 次写真蝕刻して TFT 部に活性領域として使用される半導体膜パターン 10、12 を形成する。

【0008】

図 4 を参照すれば、半導体膜パターンが形成された基板 2 の全面に 4 次写真工程を行ってゲート - パッド連結部に形成されたゲートパッド 4a の一部を露出させるフォトレジストパターン（図示せず）を形成する。次いで、前記フォトレジストパターンをマスクとして使用して前記絶縁膜 8 を蝕刻することによりゲートパッド 4a の一部を露出させるコンタクトホールを形成する。

【0009】

引続き、コンタクトホールが形成された基板の全面に、例えばクロム（Cr）を蒸着した後、前記クロム膜を 5 次写真蝕刻して TFT 部にはソース電極 14a 及びドレイン電極 14b を形成し、ゲート - パッド連結部には前記コンタクトホールを通して前記ゲートパッド 4a と連結されるパッド電極 14c を形成する。この際、前記 5 次写真蝕刻工程の進行時、TFT 部に形成された前記ゲート電極 4 の上部の不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜 12 も一部蝕刻され、ゲート電極の上部の非晶質シリコン膜 10 の一部が露出される。

【0010】

図 5 を参照すれば、ソース電極 14a、ドレイン電極 14b 及びパッド電極 14c が形成された基板 2 の全面に、例えば酸化膜を蒸着して保護膜 16 を形成した後、前記保護膜を 6 次に写真蝕刻して TFT 部のドレイン電極 14b の一部とゲート - パッド連結部のパッド電極 14c の一部を露出させるコンタクトホールを形成する。

【0011】

次いで、コンタクトホールの形成された基板の全面に透明導電物質であるITO（Indium Tin Oxide）を蒸着した後、ITO 膜を 7 次写真蝕刻することにより画素電極 18、18a を形成する。これにより、TFT ではドレイン電極 14b と画素電極 18 が連結され、ゲート - パッド連結部ではパッド電極 14c と画素電極 18a が連結される。

【0012】

【特許文献 1】米国特許第 5,054,887 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0013】

前述した従来の液晶表示装置の製造方法によれば、ゲートラインの低抵抗化のためゲート電極の物質として純粋アルミニウムを使用した。従って、アルミニウムによるヒロック（hilllock）を防止するため陽極酸化工程が伴うので、複雑な工程、生産性の減少及び製造コストの上昇の原因となつた。

【0014】

本発明の目的は写真工程の数を減らして製造費用の減少及び生産性を向上させうる液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0015】

前記目的を達成するための本発明の液晶表示装置の製造方法は、1 次写真工程を用いて TFT 部及びゲート - パッド連結部の基板上に第 1 金属膜及び第 2 金属膜が順次に積層されてなるゲート電極及びゲートパッドを各々形成する段階と、ゲート電極及びゲートパッドが形成された前記基板の全面に絶縁膜を形成する段階と、2 次写真工程を用いて TFT 部の前記絶縁膜上に半導体膜パターンを形成する段階と、3 次写真工程を用いて TFT 部に第 3 金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を形成し、パッド部に第 3 金属膜よりなるパッド電極を形成する段階と、4 次写真工程を用いて前記ドレイン電極の一部、ゲートパッドの一部及びパッド電極の一部を露出させる保護膜パターンを形成する段階と、前記保護膜パターンをマスクとして前記ゲートパッドを構成する第 2 金属膜を蝕刻して第 1

10

20

30

40

50

金属膜を露出させる段階と、5次写真工程を用いて前記TFT部のドレイン電極と連結される第1画素電極パターンと、前記ゲート-パッド連結部のゲートパッドとパッド部のパッド電極を連結する第2画素電極パターンを形成する段階とを含むことを特徴とする。

【0016】

前記第1金属膜は耐火性金属として、Cr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成し、前記2金属膜はアルミニウムまたはアルミニウム合金で形成することが望ましい。

前記第3金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成することが望ましい。

【0017】

前記1次写真工程で第2金属膜に対してテーパー蝕刻を行い、引続き第1金属膜に対して蝕刻を行うことにより、第1金属膜の幅を第2金属膜の幅より大きく形成することができる。

前記目的を達成するための本発明による液晶表示装置の他の製造方法は、1次写真蝕刻工程を用いてTFT部及びパッド部の基板上に、第1金属膜及び第2金属膜が順次に積層されてなるゲート電極及びゲートパッドを各々形成する段階と、ゲート電極及びゲートパッドが形成された前記基板の全面に絶縁膜を形成する段階と、2次写真工程を用いてTFT部の前記絶縁膜上に半導体膜パターンを形成する段階と、3次写真工程を用いてTFT部に第3金属膜よりなるソース電極及びドレイン電極を形成する段階と、ソース電極及びドレイン電極が形成された基板の全面に保護膜を形成した後、前記保護膜及び絶縁膜を4次写真蝕刻して前記TFT部のドレイン電極と前記パッド部のゲートパッドの一部を露出させる保護膜パターンを形成する段階と、前記保護膜パターンをマスクとして前記第2金属膜を蝕刻してパッド部の第1金属膜を露出させる段階と、5次写真工程を用いて前記TFT部のドレイン電極と接触する第1画素電極パターンと、前記パッドの第1金属膜と接触する第2画素電極パターンを形成する段階とを含むことを特徴とする。

【0018】

前記第1金属膜は耐火性金属として、Cr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成し、前記第2金属膜はアルミニウムまたはアルミニウム合金で形成することが望ましい。

前記第3金属膜はCr、Ta、Mo及びTiよりなるグループから選択された何れか1つで形成し、前記絶縁膜はSi_N_x及びSi_N_xとSi_O_xとの二重膜よりなるグループから選択された何れか1つで形成することが望ましい。

【0019】

そして、前記1次写真蝕刻工程で第2金属膜に対してテーパー蝕刻を行い、引続き第1金属膜に対して蝕刻を行う。

【発明を実施するための最良の形態】

【0020】

以下、添付された図面に基づき本発明の望ましい実施例を詳しく説明する。

図6は本発明による液晶表示装置を製造するための概略レイアウト図である。

部材番号100はゲートラインを形成するためのマスクパターンを、105はゲートパッドを形成するためのマスクパターンを、110はデータラインを形成するためのマスクパターンを、120は半導体膜を形成するためのマスクパターンを、130はソース電極/ドレイン電極を形成するためのマスクパターンを、140はTFT部の画素電極とドレイン電極を連結するコンタクトホールを形成するためのマスクパターンを、145はパッド部のゲートパッドと画素電極を連結するコンタクトホールを形成するためのマスクパターンを、150はTFT部の画素電極を形成するためのマスクパターンを、155はパッド部の画素電極を形成するためのマスクパターンを各々示す。

【0021】

図6を参照すれば、ゲートライン100が横に配列され、前記ゲートラインと直角方向にデータライン110がマトリックス状に配列され、前記ゲートライン100の末端には

10

20

30

40

50

ゲートパッド 105 が、前記データラインの末端にはデータパッド 115 が備えられている。前記相互隣接した 2 つのゲートラインとデータラインに境界される領域に各々マトリックス状に画素領域が配列される。各 TFT のゲート電極は各ゲートラインから画素領域内に突出された形で形成され、各 TFT のドレイン電極とゲート電極との間に半導体膜 120 が形成され、TFT のソース電極は前記データライン 110 から突出された形で形成され、透明なITOで構成される画素電極 150 が各画素領域内に形成される。

【0022】

図 7 乃至図 12 は本発明の第 1 実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。部材符号 C は TFT 部であって図 6 の I - I' 線の断面図であり、D 及び E はゲート - パッド連結部及びパッド部であって図 6 の II - II' の断面図である。 10

図 7 はゲート電極を形成する段階を示す。

【0023】

詳しくは、透明な基板 30 上に Cr のような耐火性金属を 300 ~ 4000 ほどの厚さで蒸着して第 1 金属膜 31 を形成した後、前記第 1 金属膜上にアルミニウムまたはアルミニウム合金を 1000 ~ 4000 ほどの厚さで蒸着して第 2 金属膜 33 を形成する。前記第 1 金属膜 31 は Cr 以外に Ta、Mo 及び Ti よりなるグループから選択された何れか 1 つを使用して形成することができる。そして、前記アルミニウム合金としてはアルミニウム - ネオジム (Al - Nd)、アルミニウム - タンタル (Al - Ta) を使用することができる。 20

【0024】

次いで、前記第 2 金属膜 33 及び第 1 金属膜 31 を 1 次写真蝕刻して TFT 部及びゲート - パッド連結部にゲート電極を形成する。この際、前記 1 次写真蝕刻工程は第 2 金属膜 33 に対してテーパ蝕刻を行い、連続して第 1 金属膜 31 を蝕刻することにより成される。従って、第 1 金属膜 31 の幅が第 2 金属膜 33 の幅より大きく形成される。 30

【0025】

このようにアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜の下部に耐火性金属膜を形成することにより、アルミニウムまたはアルミニウム合金膜と基板との間の熱膨張率の差に因したアルミニウムヒロックの発生を防止することができる。また、既存の蝕刻工程をそのまま適用すると共にアルミニウムまたはアルミニウム合金膜と耐火性金属膜との蝕刻率の差を用いてテーパ蝕刻ができる。従って、ゲート電極の形成後、後続物質の蒸着時に段差を良好にすることができる。 30

【0026】

図 8 は半導体膜パターンを形成する段階を示す。

詳しくは、ゲート電極が形成された前記基板 30 の全面に、例えば窒化膜または酸化膜を蒸着して絶縁膜 35 を形成する。次いで、絶縁膜が形成された前記基板 30 の全面に非晶質シリコン膜 37 及び不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜 39 を順次に蒸着して半導体膜を形成した。次いで、前記半導体膜を 2 次写真蝕刻して TFT 部に非晶質シリコン膜 37 及び不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜 39 よりなる半導体膜パターンを形成する。 40

【0027】

前記絶縁膜 35 は 2000 ~ 9000 ほどの厚さ、前記非晶質シリコン膜 37 は 1000 ~ 4000 ほどの厚さ、そして前記不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜 39 は 300 ~ 1000 ほどの厚さで形成する。

図 9 はソース電極、ドレイン電極及びパッド電極を形成する段階を示す。

詳しくは、半導体膜パターンが形成された基板の全面に Cr のような耐火性金属を 300 ~ 4000 ほど蒸着して第 3 金属膜を形成した後、前記第 3 金属膜を 3 次写真蝕刻して TFT 部にソース電極 41a 及びドレイン電極 41b を形成し、パッド部にパッド電極 41c を形成する。この際、前記 3 次写真蝕刻時、TFT 部に形成された不純物がドーピングされた非晶質シリコン膜 39 も一部蝕刻されて非晶質シリコン膜 37 の一部が露出される。 50

【0028】

図10は保護膜パターンを形成する段階を示す。

詳しくは、前記基板30の全面に、例えば窒化膜を使用して保護膜を形成した後、前記保護膜を4次写真蝕刻して保護膜パターン43を形成する。この際、TFT部のドレイン電極41b及びパッド部のパッド電極41cの一部が露出される。そして、ゲート-パッド連結部に形成されたゲート電極、即ち第2金属膜33上に形成されていた保護膜と絶縁膜35が同時に蝕刻され前記第2金属膜33が露出される。

【0029】

図11はゲート-パッド連結部の露出された第2金属膜を蝕刻する段階を示す。

詳しくは、部材番号45にて示された部分、即ちゲート-パッド連結部に位置し、前記保護膜パターン43により露出された第2金属膜33を蝕刻して第1金属膜31を露出させる。この工程により後続工程で形成される画素電極と第2金属膜との間のコンタクト抵抗を減少させうる。

【0030】

図12は画素電極を形成する段階を示す。

詳しくは、保護膜パターンが形成された基板30の全面に透明導電膜であるITOを蒸着した後、前記ITO膜を5次写真蝕刻して第1及び第2の画素電極47を形成する。これによりTFT部ではドレイン41bと第1の画素電極47が連結され、ゲート-パッド連結部のゲート電極とパッド部のパッド電極41cが第2の画素電極47を通して連結される。

10

20

30

【0031】

図13乃至図16は本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。部材符号FはTFT部であって図6のI-I'線の断面図であり、Gはパッド部であって図6のII-II'の断面図である。

図13はゲート電極を形成する段階を示す。

詳しくは、透明な基板50の全面にCr、Ta、Ti等の耐火性金属を300~400ほどの厚さで蒸着して第1金属膜51を形成した後、アルミニウムまたはアルミニウム合金を1000~4000ほどの厚さで蒸着して第2金属膜53を形成する。その後、前記第2金属膜53及び前記第1金属膜51を1次写真蝕刻してTFT部及びパッド部にゲート電極及びゲートパッドを形成する。

30

【0032】

前記ゲート電極及びゲートパッドは一枚のマスクを使用して同時に形成される。前記1次写真蝕刻はまず第2金属膜53に対してテープ蝕刻を行い、引続き第1金属膜51に対して蝕刻を行う。よって、第1金属膜51の幅が第2金属膜53の幅より広く形成される。

図14は半導体膜パターンを形成する段階を示す。

【0033】

詳しくは、ゲート電極及びゲートパッドが形成された基板50の全面に絶縁膜55及び半導体膜を形成した後、前記半導体膜を2次写真蝕刻してTFT部に活性領域にて使用される半導体膜パターン57を形成する。この際、前記絶縁膜55は窒化膜(SiNx)の単一膜または窒化膜(SiNx)及び酸化膜(SiOx)の二重膜を使用して2000~9000の厚さで形成し、前記半導体膜パターン57は非晶質シリコン膜と不純物がドーピングされた非晶質シリコンを連続に蒸着して形成することができる。

40

【0034】

図15はソース電極及びドレイン電極を形成する段階を示す。

詳しくは、半導体膜パターン57が形成された前記基板50の全面にCr、TiまたはMoのような耐火性金属を300~4000の厚さで蒸着して第3金属膜を形成した後、前記第3金属膜を3次写真蝕刻してTFT部にソース電極61a及びドレイン電極61bを形成する。

【0035】

50

図16は保護膜パターン及び画素電極を形成する段階を示す。

詳しくは、ソース電極及びドレイン電極が形成された前記基板の全面に、例えば窒化膜を蒸着して保護膜を形成した後、前記保護膜を4次写真蝕刻して保護膜パターン63を形成する。前記4次写真蝕刻時、TFT部のドレイン電極61bの一部が露出され、パッド部ではゲートパッド上部の絶縁膜と保護膜が同時に蝕刻されゲートパッドの一部が露出される。

【0036】

次いで、保護膜パターンにより露出された部分の第2金属膜53を蝕刻して第1金属膜51を露出させる。このように第2金属膜53を蝕刻することにより後続工程で形成される画素電極と第2金属膜との接触抵抗を減らすことができる。

10

その後、ITO膜を蒸着し5次写真蝕刻してTFT部のドレイン電極61bと接続される第1の画素電極65と、パッド部の第1金属膜と接続される第2の画素電極65を形成する。

【0037】

前述したように、本発明の液晶表示装置の製造方法は二重ゲート電極を使用すると共に少なくとも5回の写真蝕刻工程を適用して少なくとも7回の写真蝕刻工程が適用される従来の技術に比べて製造コストを大幅に低減し、製造収率を向上させうる。

【0038】

また、ゲート電極として耐火性金属膜とその上部に形成されるアルミニウム膜の二重膜で形成することにより、耐火性金属膜のストレス弛緩作用によりアルミニウム膜のヒロック成長を抑制することができる。

20

また、図16に示されたように、パッド部で画素電極を形成する前にアルミニウム膜またはアルミニウム合金膜を蝕刻することにより、後続工程で形成される画素電極とアルミニウム膜との間の接触抵抗を減らすことができる。

【0039】

本発明は前記実施例に限定されなく、本発明の技術的思想内で当分野の通常の知識を有する者により多くの変形が可能であることは明白である。

【図面の簡単な説明】

【0040】

30

【図1】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図2】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図3】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図4】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図5】従来の液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図6】本発明による液晶表示装置を製造するための概略レイアウト図である。

【図7】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図8】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図9】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

40

【図10】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図11】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図12】本発明の第1実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図13】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【図14】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図で

50

ある。

【図15】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

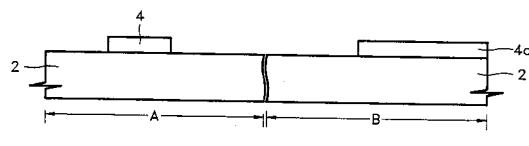
【図16】本発明の第2実施例による液晶表示装置の製造方法を説明するための断面図である。

【符号の説明】

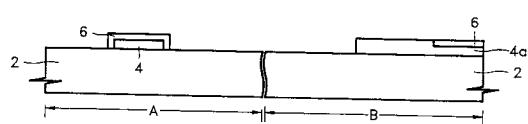
【0041】

3 0	基板	10
3 1	第1金属膜	
3 3	第2金属膜	
3 5	絶縁膜	
3 7	非晶質シリコン膜	
3 9	ドーピングされた非晶質シリコン膜	
4 1 a	ソース電極	
4 1 b	ドレイン電極	
4 1 c	パッド電極	
4 3	保護膜パターン	
4 7	画素電極	
C	TFT部	20
D	ゲート-パッド連結部	
E	パッド部	

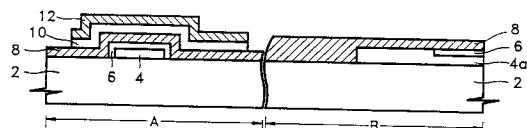
【図1】



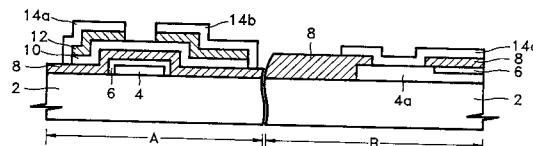
【図2】



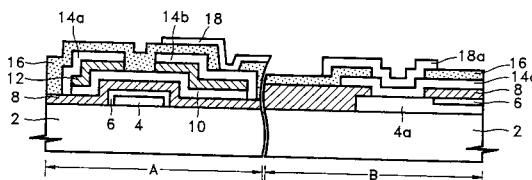
【図3】



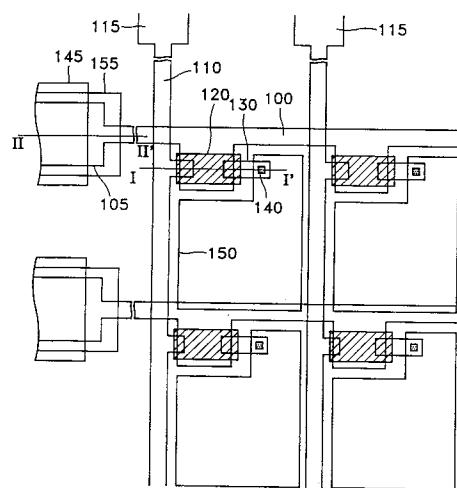
【図4】



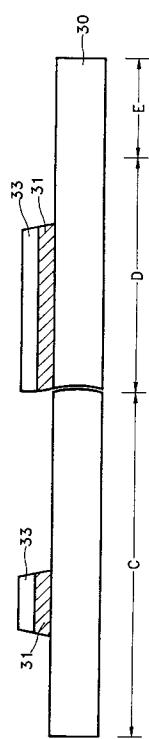
【図5】



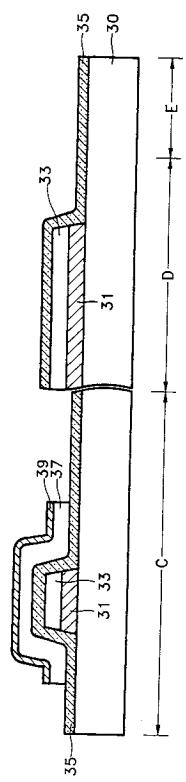
【図6】



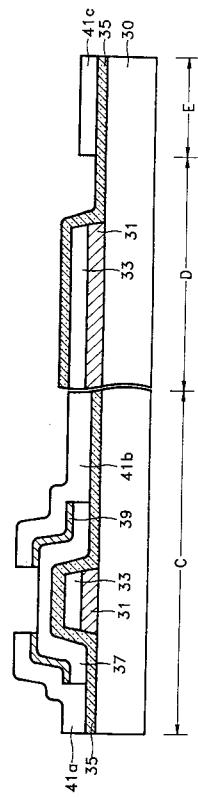
【図7】



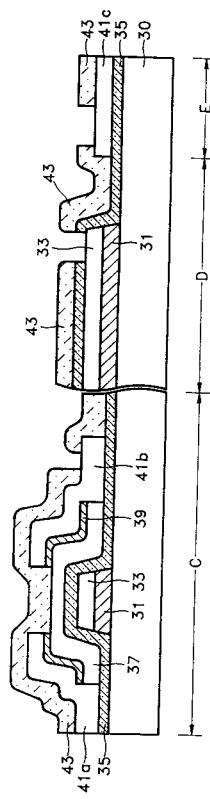
【図8】



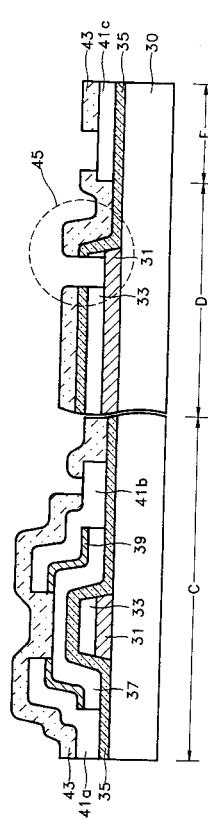
【図9】



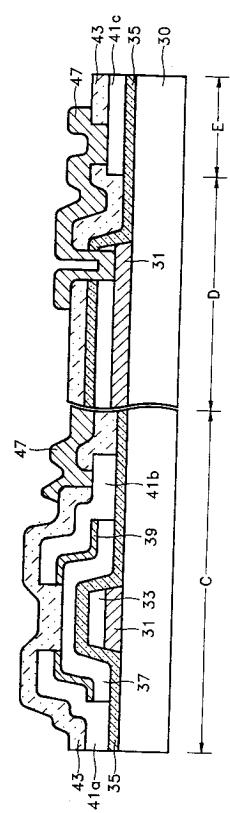
【図10】



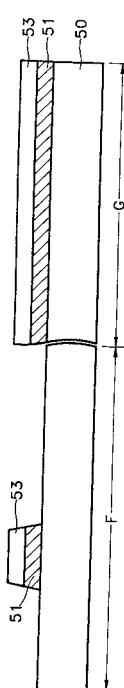
【図11】



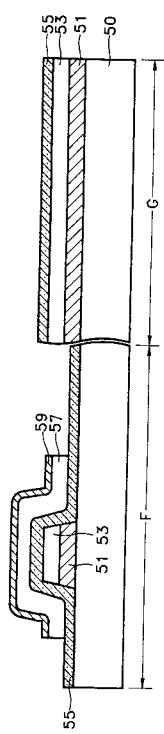
【図12】



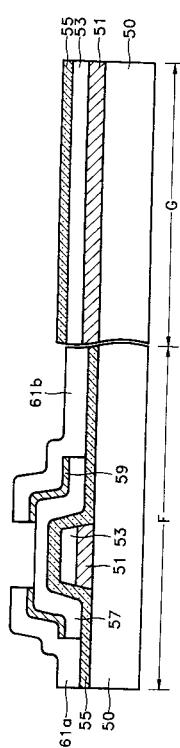
【図13】



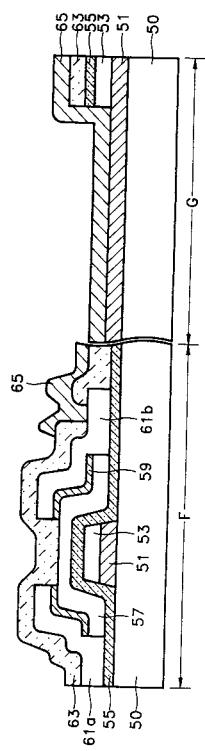
【図14】



【図15】



【図16】



フロントページの続き

(51) Int.Cl. ⁷	F I	テーマコード(参考)
H 01L 21/336	H 01L 29/78	617L
H 01L 21/768	H 01L 29/78	612D
H 01L 29/423	H 01L 29/78	617U
H 01L 29/49	H 01L 29/58	G
H 01L 29/786	H 01L 21/90	A
	H 01L 21/88	R

F ターム(参考) 4M104 AA09 BB02 BB13 BB14 BB16 BB17 BB36 CC05 DD07 FF08
FF13 GG09 GG10 GG14 HH03 HH15
5F033 GG04 HH38 JJ38 KK08 KK10 KK17 KK18 KK20 KK21 MM05
NN13 NN17 QQ08 QQ09 QQ37 RR06 VV07 VV15 XX09 XX16
XX33
5F110 AA16 BB01 CC07 EE03 EE04 EE06 EE14 EE23 EE37 FF02
FF03 FF09 FF27 GG02 GG15 GG25 HK04 HK09 HK16 HK21
HK32 HL07 NN02 QQ01

专利名称(译)	制造液晶显示装置的方法和TFT基板		
公开(公告)号	JP2004157555A	公开(公告)日	2004-06-03
申请号	JP2004000532	申请日	2004-01-05
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社		
[标]发明人	權寧贊		
发明人	權寧贊		
IPC分类号	G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1345 G02F1/136 G02F1/1362 G02F1/1368 H01L21/28 H01L21/3205 H01L21/336 H01L21/768 H01L21/77 H01L21/84 H01L23/52 H01L27/12 H01L29/423 H01L29/49 H01L29/786		
CPC分类号	G02F1/13458 G02F1/1345 G02F1/1362 H01L27/12 H01L27/124 H01L27/1288 H01L29/4908 H01L29/66765		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1343 G02F1/1345 H01L21/28.301.R H01L29/78.627.C H01L29/78.617.L H01L29/78.612.D H01L29/78.617.U H01L29/58.G H01L21/90.A H01L21/88.R		
F-TERM分类号	2H092/GA29 2H092/GA34 2H092/GA42 2H092/HA12 2H092/HA19 2H092/JA26 2H092/JA33 2H092/JA35 2H092/JA39 2H092/JA40 2H092/JA46 2H092/JB56 2H092/JB57 2H092/KA05 2H092/KA10 2H092/KA12 2H092/KA13 2H092/KA17 2H092/KA18 2H092/KB13 2H092/MA04 2H092/MA13 2H092/MA17 2H092/MA27 2H092/NA27 4M104/AA09 4M104/BB02 4M104/BB13 4M104/BB14 4M104/BB16 4M104/BB17 4M104/BB36 4M104/CC05 4M104/DD07 4M104/FF08 4M104/FF13 4M104/GG09 4M104/GG10 4M104/GG14 4M104/HH03 4M104/HH15 5F033/GG04 5F033/HH38 5F033/JJ38 5F033/KK08 5F033/KK10 5F033/KK17 5F033/KK18 5F033/KK20 5F033/KK21 5F033/MM05 5F033/NN13 5F033/NN17 5F033/QQ08 5F033/QQ09 5F033/QQ37 5F033/RR06 5F033/VV07 5F033/VV15 5F033/XX09 5F033/XX16 5F033/XX33 5F110/AA16 5F110/BB01 5F110/CC07 5F110/EE03 5F110/EE04 5F110/EE06 5F110/EE14 5F110/EE23 5F110/EE37 5F110/FF02 5F110/FF03 5F110/FF09 5F110/FF27 5F110/FFG02 5F110/GG15 5F110/GG25 5F110/HK04 5F110/HK09 5F110/HK16 5F110/HK21 5F110/HK32 5F110/HL07 5F110/NN02 5F110/QQ01 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB56 2H192/CB83 2H192/CC02 2H192/CC12 2H192/CC32 2H192/FA65 2H192/HA47 2H192/HA62		
优先权	1995 P 62170 1995-12-28 KR 1996 P 18516 1996-05-29 KR		
其他公开文献	JP3891988B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种制造液晶显示装置的方法，其中减少了光处理的数量。解决方案：形成栅电极和栅焊盘的步骤，其中通过一次光蚀刻工艺将难熔金属制成的第一金属膜和铝制成的第二金属膜通过一次光蚀刻工艺堆叠在衬底上，并在衬底的整个表面上形成绝缘膜。通过第二光工艺在TFT部分的绝缘膜上形成半导体膜图案的步骤，通过第三光工艺在TFT部分上形成由第三金属膜制成的源电极和漏电极的步骤，基板在整个表面上形成保护膜之后，形成保护膜图案的步骤，该步骤是通过对保护膜和绝缘膜进行第四次光蚀刻，并使用该保护膜图案作为掩模，使第二金属暴露出TFT部分的漏极和焊盘部分的栅极焊盘。通过第五光蚀刻工艺蚀刻膜以暴露焊盘部分的第一金属膜，接触TFT部分的漏极的第一像素电极图案和接触焊盘部分的第一金属膜的第二像素电极图案的步骤形成步骤包括。[选择图]图16

